Транзисторы Техническая информация datasheet pdf техническая документация технические характеристики описание фото рисунок маркировка габариты размер параметры применение аналог замена

Предлагаем ЭЛЕКТРОННЫЕ КОМПОНЕНТЫ (радиодетали) СО СКЛАДА И ПОД ЗАКАЗ продажа в Минске Беларусь тел.8(017)200-56-46 www.fotorele.net e:mail minsk17@tut.by

• Биполярные транзисторы

Обозначение	Прототип	Поляр-ность	Рк max Вт	Uкб max В	Uкэ max В	Uэб max В	Iк max мА	h21e	Uкэ нас В	Iкбо мкА	fгр МГц	Кш дБ	Тип корпуса Диапазон раб. темпер.
КТ209А		PNP	0,2	15	15	10	300	20 ÷60	0,4	Iкэг	5		
КТ209Б				15	15	10		40 ÷120		50			
КТ209Б1				15	15	5		>12					
КТ209В				15	15	10		80 ÷240					
КТ209В1				15	15	10		>30					
КТ209Г				30	30	10		20 ÷60					КТ-26
КТ209Д				30	30	10		40 ÷120					-45÷100°С
КТ209Е				30	30	10		80 ÷240					
КТ209Ж				45	45	20		20 ÷60					
КТ209И				45	45	20		40 ÷120					
КТ209К				45	45	20		80 ÷160					
КТ209Л				60	60	20		20 ÷60					
КТ209М				60	60	20		40 ÷120					
КТ220А9	KSC1623	NPN	0,2	60	50	5,0	100	90÷180	0,3	0,1	250		
КТ220Б9								135÷270					КТ-46А
КТ220В9								200÷400					-60÷85°С
КТ220Г9								300÷600					
КТ3102АМ	BC547A	NPN	0,25	50	50	5,0	200	100 ÷250	0,35	0,05	200	10	
КТ3102БМ	BC547B			50	50			200 ÷500	0,35	0,05	200	10	
КТ3102ВМ	BC548B			30	30			200 ÷500	0,35	0,015	200	10	
КТ3102ГМ	BC548C			20	20			400 ÷800	1,4	0,015	200	10	КТ-26
КТ3102ДМ	BC549B			30	30			200 ÷500	0,35	0,015	300	4	-45÷85°С
КТ3102ЕМ	BC549C			20	20			400 ÷1000	1,4	0,015	300	4	
КТ3102ЖМ				50	50			100 ÷250	0,35	0,05	200	-	
КТ3102ИМ				50	50			200 ÷500	0,35	0,05	200	-	
КТ3102КМ				30	30			200 ÷500	0,35	0,015	200	-	
КТ3107А		PNP	0,3	50	45	5	100	70 ÷140	0,2	0,1	250	10	
КТ3107Б	BC307A			50	45			120 ÷220				10	
КТ3107В				30	25			70 ÷140				10	
КТ3107Г	BC308A			30	25			120 ÷220				10	КТ-26
КТ3107Д	BC308B			30	25			180 ÷460				10	-60÷100°С
КТ3107Е				25	20			120 ÷220				4	
КТ3107Ж	BC309B			25	20			180 ÷460				4	
КТ3107И	BC307B			50	45			180 ÷460				10	
КТ3107К	BC308C			30	25			380 ÷800				10	
КТ3107Л	BC309C			25	20			380 ÷800				4	
КТ3117А	2N2221	NPN	0,3	60	60	4,0	400	40 ÷200	0,6	10	200		КТ1-7
КТ3117Б	2N2222		0,3	75	75			100 ÷300					КТ1-7
КТ3117А1			0,5	60	60			40 ÷200					КТ-26
													-45÷85°С
КТ3126А	BF506	PNP	0,15	30	3	3,0	30	25 ÷100	1,2	0,5	500	5	КТ-26
													-45÷85°С
КТ3127А	2N4411	PNP	0,1	20	20	3,0	25	25 ÷150		1,0	600	5	КТ1-12
													-45÷85°С
КТ3128А		PNP	0,1	40	40	3,0	20	15 ÷150		1,0	700	5	КТ1-12
													-45÷85°С
КТ3129А9		PNP	0,1	50	40	5,0	100	30 ÷120	0,2	1,0	200		
КТ3129Б9	BC857A			50	40			80 ÷250					КТ-46А
КТ3129В9	BC858A			30	20			80 ÷250					-60÷85°С
КТ3129Г9	BC858B			30	20			200 ÷500					
КТ3129Д9				20	20			200 ÷500					

• Биполярные транзисторы (продолжение)

Обозначение	Прототип	Поляр-ность	Рк max Вт	Uкб max В	Uкэ max В	Uэб max В	Iк max мА	h21e	Uкэ нас В	Iкбо мкА	fгр МГц	Кш дБ	Тип корпуса Диапазон раб. темпер.
КТ3130А9	BCW71	NPN	0,1	50	40	5,0	100	100 ÷250		0,1	150	-	
КТ3130Б9	BCW72			50	40			200 ÷500			150	10	
КТ3130В9	BCW32			30	20			200 ÷500			150	10	КТ-46А
КТ3130Г9				20	15			400 ÷1000			300	10	-60÷85°С
КТ3130Д9				30	20			200 ÷500			150	4	
КТ3130Е9				20	15			400 ÷1000			300	4	
КТ3130Ж9				30	25			100 ÷500	0.3		150	-	
КТ3142А	2N2369	NPN	0,36	40	40	4,5	200	40 ÷120	0,25	0,4	500		КТ1-7 -45÷85°С
КТ315А1		NPN	0,15	25	25	6,0	100	30 ÷120	0,4	0,5	250		
КТ315Б1			0,15	20	20	6,0	100	50 ÷350	0,4	0,5			
КТ315В1			0,15	40	40	6,0	100	30 ÷120	0,4	0,5			
КТ315Г1			0,15	35	35	6,0	100	50 ÷350	0,4	0,5			КТ-26
КТ315Д1			0,15		40	6,0	100	20 ÷90	0,6	0,6			-45÷100°С
КТ315Е1			0,15		35	6,0	100	50 ÷350	0,6	0,6			
КТ315Ж1			0,1		20		50	30 ÷250	0,5	0,6			
КТ315И1			0,1		60		50	>30	0,9	0,6			
КТ315Н1			0,15	20	20	6,0	100	50 ÷350	0,4	0,5			
КТ315Р1			0,15	35	35	6,0	100	150 ÷350	0,4	0,5			
КТ3153А9/ ИМ		NPN	0,3	60	50	5,0	400	100 ÷300	0,35	0,05	250		КТ-46А -45÷85°С
КТ3157А		PNP	0,2	250	250	5,0	30	>50	1,0	0,1	60		КТ-26 -45÷100°С
КТ3189А9	BC847A	NPN	0,225	50	45	6,0	100	110 ÷220	0,6	0,015	300	10	КТ-46А
КТ3189Б9	BC847B							200 ÷450					-60÷85°С
КТ3189В9	BC847C							420 ÷800					
КТ361А2		PNP	0,15	25	25	5,0	100	20 ÷90	0,4	1,0	250		
КТ361А3				25	25		100	20 ÷90	0,4	1,0	150		
КТ361Б2				20	20		100	50 ÷350	0,4	1,0	250		
КТ361В2				40	40		100	40 ÷160	0,4	1,0	250		
КТ361Г2				35	35		100	50 ÷350	0,4	0,1	250		
КТ361Г3				35	35		100	100 ÷350	0,4	0,1	250		
КТ361Д2				40	40		50	20 ÷90	1,0	1,0	250		
КТ361Д3				40	40		50	20 ÷90	1,0	1,0	150		КТ-26
КТ361Е2				35	35		50	50 ÷350	1,0	1,0	250		-60÷100°С
КТ361Ж2				10	10		50	50 ÷350	1,0	1,0	250		
КТ361И2				15	15		50	>230	1,0	1,0	250		
КТ361К2				60	60		50	50 ÷350	1,0	1,0	250		
КТ361Л2				20	20		100	50 ÷350	0,3	0,1	250		
КТ361М2				40	40		100	70 ÷160	0,3	0,05	250		
КТ361Н2				45	45		50	20 ÷90	0,4	0,1	150		
КТ361П2				50	45		50	100 ÷350	0,3	0,05	300		
КТ368АМ		NPN	0,225	15	15	4,0	30	50 ÷450		0,5	900	3,3	
КТ368БМ			0,225					50 ÷450				-	КТ-26
КТ368ВМ			0,225					100 ÷450				-	КТ-46А
КТ368А9	BF599		0,1					50 ÷300				3,3	-60÷100°С
КТ368Б9			0,1					50 ÷300				-	
КТ384А-2		NPN	0,2-0,3	30	30	4,0	300	30 ÷180	0,6	10,0	450		б/к
КТ384АМ-2													
КТ385А-2		NPN	0,2-0,3	65	65	4,0	300	40 ÷200	0,4	1,0	200		
КТ385АМ-2								40 ÷200					б/к
КТ385БМ-2								20 ÷100					

• Биполярные транзисторы (продолжение)

Обозначение	Прототип	Поляр-ность	Рк max Вт	Uкб max В	Uкэ max В	Uэб max В	Iк max мА	h21e	Uкэ нас В	Iкбо мкА	fгр МГц	Кш дБ	Тип корпуса Диапазон раб. темпер.
КТ502А КТ502Б КТ502В КТ502Г КТ502Д КТ502Е		PNP	0,35	40 40 60 60 80 90	25 25 40 40 60 80	5,0	150	40 ÷120 80 ÷240 40 ÷120 80 ÷240 40 ÷120 40 ÷120	0,6	1,0	5,0		КТ-26 -45÷100°С
КТ503А КТ503Б КТ503В КТ503Г КТ503Д КТ503Е		NPN	0,35	40 40 60 60 80 100	25 25 40 40 60 80	5,0	150	40 ÷120 80 ÷240 40 ÷120 80 ÷240 40 ÷120 40 ÷120	0,6	1,0	5,0		КТ-26 -45÷100°С
КТ520А КТ520Б	MPSA42 MPSA43	NPN	0,625	300 200	300 200	6,0	500	>40	0,5 0,4	100	50		КТ-26* -60÷85°С
КТ521А КТ521Б	MPSA92 MPSA93	PNP	0,625	300 200	300 200	5,0	500	>40	0,5 0,4	100	50		КТ-26* -60÷85°С
КТ538А	MJE13001	NPN	0,7	600	400	9,0	500	5-90	0,5	Iкэк 100	4,0		КТ-26 -45÷125°С
КТ607А-4 КТ607Б-4		NPN	1,5	40 30	35 30	4,0	150			1000	700		б/к
КТ610А КТ610Б		NPN	1,5	26	26	4,0	300	50 ÷300 20 ÷300		500	1000 700		КТ-16-2 -45÷85°С
КТ6109А КТ6109Б КТ6109В КТ6109Г КТ6109Д	SS9012D SS9012E SS9012F SS9012G SS9012H	PNP	0,625	40	20	5,0	500	64 ÷91 78 ÷112 96 ÷135 112 ÷166 144 ÷202	0,6	0,1			КТ-26 -45÷100°С
КТ6110А КТ6110Б КТ6110В КТ6110Г КТ6110Д	SS9013D SS9013E SS9013F SS9013G SS9013H	NPN	0,625	40	20	5,0	500	64 ÷91 78 ÷112 96 ÷135 112 ÷166 144 ÷202	0,6	0,1			КТ-26 -45÷100°С
КТ6111А КТ6111Б КТ6111В КТ6111Г	SS9014A SS9014B SS9014C SS9014D	NPN	0,45	50	45	5,0	100	60 ÷150 100 ÷300 200 ÷600 400 ÷1000	0,3	0,05	150	10	КТ-26 -45÷85°С
КТ6112А КТ6112Б КТ6112В	SS9015A SS9015B SS9015C	PNP	0,45	50	45	5,0	100	60 ÷150 100 ÷300 200 ÷600	0,7	0,05	100	10	КТ-26 -45÷85°С
КТ6113А КТ6113Б КТ6113В КТ6113Г КТ6113Д КТ6113Е	SS9018D SS9018E SS9018F SS9018G SS9018H SS9018I	NPN	0,4	30	15	5,0	50	28 ÷45 39 ÷60 54 ÷80 72 ÷108 97 ÷146 132 ÷198	0,5	0,05	700		КТ-26 -45÷85°С
КТ6114А КТ6114Б КТ6114В КТ6114Г КТ6114Д КТ6114Е	SS8050B SS8050C SS8050D	NPN	1,0 1,0 1,0 0,7 0,7 0,7	40	25	6,0	1500 1500 1500 1100 1100 1100	85 ÷160 120 ÷200 160 ÷300 85 ÷160 120 ÷200 160 ÷300	0,5	0,1	100		КТ-26 -45÷100°С

* освоение в корпусе КТ-92 (IPAK), КТ-89 (DPAK)

• Биполярные транзисторы (продолжение)

Обозначение	Прототип	Полярность	Рк max Вт	Uкб max В	Uкэ max В	Uэб max В	Iк max мА	h21e	Uкэ нас В	Iкбо мкА	fгр МГц	Кш дБ	Тип корпуса Диапазон раб. темпер.
КТ6115А КТ6115Б КТ6115В КТ6115Г КТ6115Д КТ6115Е	SS8550B SS8550C SS8550D	PNP	1,0 1,0 1,0 0,7 0,7 0,7	40	25	6,0	1500 1500 1500 1100 1100 1100	85 ÷160 120 ÷200 160 ÷300 85 ÷160 120 ÷200 160 ÷300	0,5	0,1	100		КТ-26 -45÷100°С
КТ6116А КТ6116Б	2N5401 2N5400	PNP	0,625	160 130	150 120	5,0	600	60 ÷240 40 ÷180	0,5	0,05 0,1	100	8,0	КТ-26 -45÷100°С
КТ6117А КТ6117Б	2N5551 2N5550	NPN	0,625	180 160	160 140	6,0	600	80 ÷250 60 ÷250	0,2 0,25	0,05 0,1	100	8,0	КТ-26 -45÷100°С
КТ6128А КТ6128Б КТ6128В КТ6128Г КТ6128Д КТ6128Е	SS9016D SS9016E SS9016F SS9016G SS9016H SS9016I	NPN	0,4	30	20	4,0	25	28 ÷45 39 ÷60 54 ÷80 72 ÷108 97 ÷146 132 ÷198	0,3	0,1	400	5,0	КТ-26 -60÷100°С
КТ6136А	2N3906	PNP	0,625	40	40	5,0	200	100 ÷300	0,4	Iкэг 0,05	250		КТ-26 -55÷100°С
КТ6137А	2N3904	NPN	0,625	60	40	6,0	200	100 ÷300	0,3	Iкэг 0,05	300		КТ-26 -55÷100°С
КТ624А-2 КТ624АМ-2		NPN	1,0	30	30	4,0	1000	30 ÷180	0,9	100	450		б/к
КТ625А-2 КТ625АМ-2		NPN	1,0	60	40	4,0	1000	20 ÷200	1,2	30	200		б/к
КТ634Б-2		NPN	1,2	30		3,0	150			1000	1500		б/к
КТ635Б	2N3725	NPN	0,5	60	60	5,0	1000	20 ÷150	0,52	30	300		КТ2-7 -45÷85°С
КТ637А-2 КТ637Б-2		NPN	1,5	30		2,5	200			100 2000	1300 800		б/к
КТ645А КТ645Б		NPN	0,5	60 40	50 40	4 5	300	20 ÷200 >80	0,5 0,05	1.0	250		КТ-26 -45÷85°С
КТ646А КТ646Б КТ646В	2SC495 2SC496	NPN	1,0	60 40 40	60 40 40	4	1000	40 ÷200 >150 150 ÷340	0,85 0,25 0,25	10 10 0,05	250		КТ-27* -45÷85°С
КТ660А КТ660Б	BC337 BC338	NPN	0,5	50 30	45 30	5	800	110 ÷220 200 ÷450	0,5	1,0	200		КТ-26 -45÷85°С
КЕ703А	IRGB14C40L		100		370		20000		1.7при Iк=14А	Iкэк 25			КТ-28-2 -45÷150°С
КТ732А	MJE4343	NPN	90	160	160	7	16000	>15	2,0	750	1,0		КТ-43 -60÷100°С
КТ733А	MJE4353	PNP	90	160	160	7	16000	>15	2,0	750	1,0		
КТ738А	TIP3055	NPN	90	100	60	7	15000	20 ÷70	1,1	1,0			КТ-43 -60÷125°С
КТ739А	TIP2955	PNP	90	100	60	7	15000	20 ÷70	1,1	1,0			
КТ742А-5/ИМ КТ942Б-5/ИМ		NPN	60	700 600	600 500	9,0	1000	6,0÷38 5,0÷40		400			б/к -40÷100°С
КТ805АМ КТ805БМ КТ805ВМ КТ805ИМ		NPN	30,0	300	Uкэг 160 135 135 60	5,0	5000	>15 >15 >15 >25	- - 2,5 3,0	1.0			КТ-28-2 -60÷100°С
КТ8126А1 КТ8126Б1	MJE13007 MJE13006	NPN	80,0	700 600	400 300	9,0	8000	8 ÷40	1,0	Iкэк 100	4,0		КТ-28-2 -45÷100°С

* освоение в корпусе КТ-92 (IPAK), КТ-89 (DPAK)

• Биполярные транзисторы (продолжение)

Обозначение	Прототип	Поляр-ность	Рк max Вт	Uкб max В	Uкэ max В	Uэб max В	Iк max мА	h21e	Uкэ нас В	Iкбо мкА	fгр МГц	Кш дБ	Тип корпуса Диапазон раб. темпер.
КТ814А КТ814Б КТ814В КТ814Г	 BD136 BD138 BD140	PNP	10		40 50 70 100	5,0	1500	40 ÷275 40 ÷275 40 ÷275 30 ÷275	0,6	50	40		 КТ-27* -60÷125°С
КТ815А КТ815Б КТ815В КТ815Г	 BD135 BD137 BD139	NPN	10		40 50 70 100	5,0	1500	40 ÷275 40 ÷275 40 ÷275 30 ÷275	0,6	50	40		 КТ-27* -60÷125°С
КТ816А КТ816Б КТ816В КТ816Г	 BD234 BD236 BD238	PNP	25		40 45 60 100	5,0	3000	25 ÷275	0,6	100	3,0		 КТ-27* -60÷150°С
КТ8164А КТ8164Б	MJE13005 MJE13004	NPN	75	700 600	400 300	9,0	4000	8,0 ÷40	0,5	100	4,0		КТ-28-2* -45÷100°С
КТ817А КТ817Б КТ817В КТ817Г	 BD233 BD235 BD237	NPN	25		40 45 60 100	5,0	3000	25 ÷275	0,6	100	3,0		 КТ-27* -60÷150°С
КТ8170А1,А9 КТ8170Б1,Б9	MJE13003 MJE13002	NPN	40	700 600	400 300	9,0	1500	8,0 ÷40	0,5	Iкэк 100	4,0		КТ-27* -60÷100°С
КТ8176А КТ8176Б КТ8176В	TIP31A TIP31B TIP31C	NPN	40	60 80 100	60 80 100	5,0	3000	>25	1,2	Iкэо, мА 0,3	3,0		КТ-28-2* -60÷100°С
КТ8177А КТ8177Б КТ8177В	TIP32A TIP32B TIP32C	PNP	40	60 80 100	60 80 100	5,0	3000	>25	1,2	Iкэо, мА 0,3	3,0		КТ-28-2* -60÷100°С
КТ818А КТ818Б КТ818В КТ818Г		PNP	60		40 50 70 90	5,0	10000	15 ÷225 20 ÷225 15 ÷225 12 ÷225	2,0	1000	3,0		 КТ-28-2 -45÷100°С
КТ819А КТ819Б КТ819В КТ819Г		NPN	60		40 50 70 100	5,0	10000	15 ÷275 20 ÷275 15 ÷275 12 ÷275	2,0	1000	3,0		 КТ-28-2 -45÷100°С
КТ8212А КТ8212Б КТ8212В	TIP41C TIP41B TIP41A	NPN	65	100 80 60	100 80 60	5,0	6000	15÷75	1,5	Iкэо 400	3,0		КТ-28-2* -60÷100°С
КТ8213А КТ8213Б КТ8213В	TIP42C TIP42B TIP42A	PNP	65	100 80 60	100 80 60	5,0	6000	15÷75	1,5	Iкэо 400	3,0		КТ-28-2* -60÷100°С
КТ8224А	BU2508A	NPN	100	1500	700	7,5	8000	4,0÷7,0	1,0	1000			КТ-43 -60÷125°С
КТ8228А	BU2525A	NPN	125	1500	800	7,5	12000	5,0÷9,5	5,0	Iэбо 1,0			КТ-43 -25÷125°С
КТ8229А	TIP35F	NPN	125	180	180	5,0	25000	15÷75	1,8	Iкэо 1,0	3,0		КТ-43 -60÷125°С
КТ8230А	TIP36F	PNP	125	180	180	5,0	25000	15÷75	1,8	1,0	3,0		КТ-43 -60÷125°С
КТ8248А	BU2506F	NPN	90	Uкэк 1500	700	7,5	5000	3.8÷9.0	3,0	Iкэк, мА 1,0			КТ-43 -25÷125°С
КТ8270А	MJE13001	NPN	7,0	600	400	9,0	500	5,0-90	0,5	Iкэк 100	4		КТ-27 -45÷125°С

* освоение в корпусе КТ-92 (IPAK), КТ-89 (DPAK)

• Биполярные транзисторы (продолжение)

Обозначение	Прототип	Поляр-ность	Рк max Вт	Uкб max В	Uкэ max В	Uэб max В	Iк max мА	h21e	Uкэ нас В	Iкбо мкА	fгр МГц	Кш дБ	Тип корпуса Диапазон раб. темпер.
КТ8271А КТ8271Б КТ8271В	BD136 BD138 BD140	PNP	10	45 60 80	45 60 80	5,0	1500	>25	0,5	0,1			КТ-27 -60÷125°С
КТ8272А КТ8272Б КТ8272В	BD135 BD137 BD139	NPN	10	45 60 80	45 60 80	5,0	1500	>25	0,5	0,1			КТ-27 -60÷125°С
КТ8290А	BUH100	NPN	100	700	400	9,0	10000	>10	1,0	Iкэк 100			КТ-28-2 -25÷125°С
КТ8296А КТ8296Б КТ8296В КТ8296Г	KSD882	NPN	10	40	30	5,0	3000	60 ÷120 100 ÷200 160 ÷320 200 ÷400	0,5	100			КТ-27 -60÷125°С
КТ8297А КТ8297Б КТ8297В КТ8297Г	KSB772	PNP	10	30	30	5,0	3000	60 ÷120 100 ÷200 160 ÷320 200 ÷400	0,5	100			КТ-27 -60÷125°С
КТ8301А-5 Разработка		NPN	30		160	5,0	10000	>100	0,5	Iкэк 100			б/к -45÷125°С
КТ837А, А1/ИМ КТ837Б, Б1/ИМ КТ837В, В1/ИМ КТ837Г, Г1/ИМ КТ837Д, Д1/ИМ КТ837Е, Е1/ИМ КТ837И, И1/ИМ КТ837К, К1/ИМ КТ837Л, Л1/ИМ КТ837М, М1/ИМ КТ837Н, Н1/ИМ КТ837П, П1/ИМ КТ837С, С1/ИМ КТ837Т, Т1/ИМ КТ837У, У1/ИМ КТ837Ф, Ф1/ИМ КТ837Х, Х1/ИМ		PNP	30/25	80 80 80 60 60 60 45 45 80 80 80 60 60 45 45 45 100	60 60 60 45 45 45 30 30 60 60 60 45 45 30 30 30 80	15 15 15 15 15 15 15 15 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 15	7500	10 ÷40 20÷80 50÷150 10÷40 20÷80 50÷150 20÷80 50÷150 10÷40 20÷80 50÷150 10÷40 50÷150 10÷40 20÷80 50÷150 >20	2,5 2,5 2,5 0,9 0,9 0,9 0,5 0,5 2,5 2,5 2,5 0,9 0,9 0,5 0,5 0,5 0.6	150			КТ-28-2, КТ-92 -60÷100°С
КТ872А КТ872Б КТ872В	BU508A BU508	NPN	100	1500 1200	700 600	6,0	8000	>6,0	0,5 5,0 1,0	Iкэк мА 1,0 1,0 0,6	4,0		КТ-43 -60÷125°С
КТ913А КТ913Б КТ913В		NPN	4,7 8,0 12,0	55	55	3,5	500 1000 1000	>20		Iкэг 2500 5000 5000	900		КТ-16-2 -45÷85°С
КТ916А КТ916Б		NPN	30	55	55	3,5	2000			25000 40000	1100 900		КТ-16-2 -60÷100°С
КТ918А-2 КТ918Б-2		NPN	2,5	30		2,5	250			2,0	800 1000		б/к
КТ928А КТ928Б КТ928В	2N2218 2N2219 2N2219A	NPN	0,5	60 60 75	60 60 75	5,0	800	20÷100 50÷200 100÷300	1,0 1,0 1,0	5,0 5,0 1,0	250 250 250		КТ2-7 -45÷85°С
КТ938Б-2		NPN	1,5	28		2,5	180			1000	1800		б/к

• Биполярные транзисторы (продолжение)

Обозначение	Прототип	Поляр-ность	Рк max Вт	Uкб max В	Uкэ max В	Uэб max В	Iк max мА	h21e	Uкэ нас В	Iкбо мкА	fгр МГц	Кш дБ	Тип корпуса Диапазон раб. темпер.
КТ939А, А1 КТ939Б, Б1 КТ939В, В1		NPN	4,0	30	30	3,5	400	40÷200 20÷200 40÷200		1000 2000 1000	2500 1500 2400		КТ-16-2, КТ-16А-2 -60÷100°С
КТ940А КТ940Б КТ940В	BF459 BF458 BF457	NPN	10	300 250 160	300 250 160	5,0	100	>25	1,0	0,05			КТ-27* -45÷85°С
КТ961А КТ961Б КТ961В	BD135 BD137 BD139	NPN	12,5	100 80 60	80 60 45	5,0	1500	40÷100 63÷160 100÷250	0,5	10			КТ-27* -45÷85°С
КТ969А	BF469	NPN	6,0	300	250	5,0	100	50÷250	1,0	0,05	60		КТ-27 -45÷85°С

* освоение в корпусе КТ-92 (IPAK), КТ-89 (DPAK)

• Мощные биполярные транзисторы Дарлингтона

Обозначение	Прототип	Поляр-ность	Рк max Вт	Uкб max В	Uкэ max В	Uэб max В	Iк max мА	h21e	Uкэ нас В	Iкбо мкА	fгр МГц	Тип корпуса Диапазон раб. темпер.
КТ8115А КТ8115Б КТ8115В	TIP127 TIP126 TIP125	PNP	65	100 80 60	100 80 60	5,0	5000	>1000	2,0	200	4,0	КТ-28-2* -60÷125°С
КТ8116А КТ8116Б КТ8116В	TIP122 TIP121 TIP120	NPN	65	100 80 60	100 80 60	5,0	5000	>1000	2,0	200	4,0	КТ-28-2* -60÷125°С
КТ8156А КТ8156Б	BU807	NPN	60	330	150 200	6,0	8000	>100	1,5	1000		КТ-28-2 -60÷100°С
КТ8158А КТ8158Б КТ8158В	BDV65 BDV65A BDV65B	NPN	90	60 80 100	60 80 100	5,0	12000	>1000	2,0	400		КТ-43 -60÷125°С
КТ8159А КТ8159Б КТ8159В	BDV64 BDV64A BDV64B	PNP	90	60 80 100	60 80 100	5,0	12000	>1000	2,0	400		КТ-43 -60÷125°С
КТ8214А КТ8214Б КТ8214В	TIP110 TIP111 TIP112	NPN	50	60 80 100	60 80 100	5,0	2000	>500	2,5	1000		КТ-28-2* -60÷100°С
КТ8215А КТ8215Б КТ8215В	TIP115 TIP116 TIP117	PNP	50	60 80 100	60 80 100	5,0	2000	>500	2,5	1000		КТ-28-2* -60÷100°С
КТ8225А	BU941ZP	NPN	155	350	350	5,0	15000	>300	2,7	100		КТ-43 -60÷125°С
КТ8251А	BDV65F	NPN	125.0	180	180	5,0	10000	>1000	2.0	0.4		КТ-43 -45÷125°С
КТ972А КТ972Б КТ972В КТ972Г	BD875	NPN	8,0	60 45 60 60	60 45 60 60	5,0	2000	>750 >750 750÷5000 750÷5000	1,5 1,5 1,5 0,95	Iкэг, мА 1,0 - 1,0 0,3	200	КТ-27* -45÷85°С
КТ973А КТ973Б КТ973В	BD876	PNP	8,0	60 45 60	60 45 60	5,0	2000	>750 >750 750÷5000	1,5 1,5 1,5	Iкэг, мА 1,0 - 1,0	200	КТ-27* -45÷85°С

* освоение в корпусе КТ-92 (IPAK), КТ-89 (DPAK)

• Биполярные транзисторы с интегральными антинасыщающими элементами

Обозначение	Прототип	Поляр-ность	Рк max Вт	Uкб max В	Uкэ max В	Uэб max В	Iк max мА	h21e	Uкэ нас В	Iкэк мкА	Тип корпуса Диапазон раб. темпер.
КТ8247А	BUL45D2	NPN	75	700	400	12	5000	>22	0,5	100	КТ-28-2 -25÷125°С
КТ8261А	BUD44D2	NPN	25	700	400	9,0	2000	>10	0,65	50	КТ-27 -25÷125°С

• Биполярные транзисторы с демпфирующим диодом и резистором в цепи эмиттер-база

Обозначе-ние	Прототип	Поляр-ность	Рк max Вт	Uкэк max В	Uкэ max В	Uэб max В	Iк max мА	h21e	Uкэ нас В	Rэб Ом	Uпр диода В	Iпр А	Тип корпуса Диапазон раб. темпер.
КТ8224Б	BU2508D	NPN	100	1500	700	7,5	8000	4÷9,0	1,5	40-75	2,0	4,5	КТ-43 -60÷125°С
КТ8228Б	BU2525D	NPN	125	1500	800	6,0	12000	5÷9,5	5,0	40-75	2,0	8	КТ-43 -25÷125°С
КТ8248А1	BU2506D	NPN	90	1500	700	7,5	5000	3,8÷9,0	3,0	40-80	2,0	3	КТ-43 -25÷125°С
КТ872Г	BU508D	NPN	100	1500	700	6,0	8000	>6	0,5	40-80	2,0	4,5	КТ-43 -60÷125°С

• Однопереходные биполярные транзисторы

Обозна-чение	Прототип	P max (Вт)	Uмеж.баз. max (В)	Iэ имп. (А)	Iэ обр. (мкА)	Uостат. (В)	h тока	Тип корпуса Диапазон раб. темпер.
КТ132А КТ132Б	2N2646 2N2647	0,3	35	2,0	12,0 0,2	0,7 ÷ 3,5	0,56÷0,75 0,68÷0,82	Case22A-01 -60÷125°С
КТ133А КТ133Б	2N4870 2N4871	0,3	35	1,5	1,0	0,7 ÷ 2,5	0,56÷0,75 0,70÷0,85	КТ-26 -60÷125°С

• Маломощные n-канальные полевые транзисторы

Обозначе-ние	Прототип	P max Вт	Uзи max В	Uси max В	Uзи пор В	Rси Ом	Iс max мА	Iост мкА	S А/В	Тип корпуса Диапазон раб. темпер.
КП214А9	2N7002LT1	0,2	±40	60	1,0÷2,5	7,5	115	1,0	0,08	КТ-46А -55÷125°С
КП501А КП501Б КП501В	ZVN2120	0,5	±20	240 200 200	1,0÷3,0 1,0÷3,0 -	10 10 15	180	10	>0,1	КТ-26 -55÷100°С
КП502А	BSS124	0,7	±10	400	1,5÷2,5	28	120	1,0	0,1	КТ-26 -55÷125°С
КП503А Разработка	BSS129	1,0	±20	240	-1,8÷ -0,7	20	150	0,1	0,14	КТ-26 -55÷125°С
КП504А, Б КП504В КП504Г КП504Д КП504Е	BSS88	1,0 0,7 0,7 0,7 0.7	±10	240 200 250 240 240	0,6÷1,2	8,0 8,0 10 8,0 8,0	250 200 180 200 200	1,0	0,14	КТ-26 -55÷125°С

• Маломощные n-канальные полевые транзисторы (продолжение)

Обозначе-ние	Прототип	P max Вт	Uзи max В	Uси max В	Uзи пор В	Rси Ом	Iс max мА	Iост мкА	S А/В	Тип корпуса Диапазон раб. темпер.
КП505А, Б КП505В КП505Г	BSS295	1,0 1,0 0,7	±20 ±20 ±10	50 60 8,0	0,8÷2,0 0,8÷2,0 0,4÷0,8	0,3 0,3 1,2	1400 1400 500	1,0	0,5 0,5 -	КТ-26 -55÷125°С
КП509А9 КП509Б9 КП509В9	BSS131	0,36 0,50 0,36	±14	240 240 200	0,8÷2,0 0,6÷1,2 0,8÷2,0	16 8,0 16	100 250 100		0,16 0,14 0,06	КТ-46А -55÷125°С
КП511А КП511Б	TN0535 TN0540	0,75	±20	350 400	0,8÷2,0	22	140	10	0,125	КТ-26 -45÷125°С
КП523А КП523Б	BSS297A	1,0	±14	200	0,8÷2,0	2,0 4,0	480 340	1,0	0,5	КТ-26 -55÷125°С

• Маломощные p-канальные полевые транзисторы

Обозначение	Прототип	P max Вт	Uзи max В	Uси max В	Uзи пор В	Rси Ом	Iс max мА	Iост мкА	S А/В	Тип корпуса Диапазон раб. темпер.
КП507А	BSS315	1,0	±20	-50	-0,8÷(-2,0)	0,8	-1100	-1,0	0,25	КТ-26 -55÷125°С
КП508А	BSS92	1,0	±20	-240	-0,8÷(-2,0)	20	-150	-1,0	0,06	КТ-26 -55÷125°С

• Мощные n-канальные полевые транзисторы

Обозначение	Прототип	Uси max В	Rси Ом	Iс max А	Uзи max В	P max Вт	Uзи пор В	Тип корпуса Диапазон раб. темпер.
КП7129А	SSU1N60	600	11,5	1,2	±20	40	2,0÷4,0	КТ-28-2 -55÷125°С
КП7173А	STP4NK60Z	600	2,0	4,0	±30	70	3,0÷4,5	КТ-28-2 -45÷125°С
КП723А КП723Б КП723В	IRFZ44 IRFZ45 IRFZ40	60 60 50	0,028 0,035 0,028	50	±20	150	2,0÷4,0	КТ-28-2 -55÷150°С
КП723АМ	IRFZ44E	60	0,023	48	±20	110	2,0÷4,0	КТ-28-2 -55÷150°С
КП726А, А1 КП726Б, Б1	BUZ90A BUZ90	600	2,0 1,6	4,0 4,5	±20	75	2,0÷4,0	КТ-28-2 КТ-90 -55÷125°С
КП727А КП727Б	BUZ71 IRFZ34	50 60	0,1 0,05	14 30	±20	40 88	2,1÷4,0 2,0÷4,0	КТ-28-2 -55÷150°С
КП731А КП731Б КП731В	IRF710 IRF711 IRF712	400 350 400	3,6 3,6 5,0	2,0 2,0 1,7	±20	36	2,0÷4,0	КТ-28-2 -55÷125°С
КП737А КП737Б КП737В	IRF630 IRF634 IRF635	200 250 250	0,4 0,45 0,68	9,0 8,1 6,5	±20	74	2,0÷4,0	КТ-28-2 -55÷125°С
КП739А КП739Б КП739В	IRFZ14 IRFZ10 IRFZ15	60 50 60	0,2 0,2 0,32	10 10 8,3	±20	43	2,0÷4,0	КТ-28-2 -55÷150°С
КП740А КП740Б КП740В	IRFZ24 IRFZ20 IRFZ25	60 50 60	0,1 0,1 0,12	17 17 14	±20	60	2,0÷4,0	КТ-28-2 -55÷150°С
КП741А КП741Б	IRFZ48 IRFZ46	60 50	0,018 0,024	50	±20	190 150	2,0÷4,0	КТ-28-2 -55÷150°С

• Мощные n-канальные полевые транзисторы (продолжение)

Обозначение	Прототип	Uси max В	Rси Ом	Iс max А	Uзи max В	P max Вт	Uзи пор В	Тип корпуса Диапазон раб. темпер.
КП742А КП742Б	STH75N06 STH80N05	60 50	0,014 0,012	75 80	±20	200	2,0÷4,0	КТ-43 -55÷125°С
КП743А КП743Б КП743В	IRF510 IRF511 IRF512	100 80 100	0,54 0,54 0,74	5,6 5,6 4,9	±20	43	2,0÷4,0	КТ-28-2 -55÷150°С
КП743А1 КП743Б1 КП743А9		100	0,54	5,5	±20	40	2,0÷4,0 1,2÷2,0 2,0÷4,0	КТ-27 КТ-89 -55÷150°С
КП744А КП744Б КП744В	IRF520 IRF521 IRF522	100 80 100	0,27 0,27 0,36	9,2 9,2 8,0	±20	60	2,0÷4,0	КТ-28-2 -55÷150°С
КП745А КП745Б КП745В	IRF530 IRF531 IRF532	100 80 100	0,16 0,16 0,23	14 14 12	±20	88	2,0÷4,0	КТ-28-2 -55÷150°С
КП746А, А1 КП746Б, Б1 КП746В, В1	IRF540 IRF541 IRF542	100 80 100	0,077 0,077 0,1	28 28 25	±20	150	2,0÷4,0	КТ-28-2 КТ-90 -55÷150°С
КП747А	IRFP150	100	0,055	41	±20	230	2,0÷4,0	КТ-43 -55÷150°С
КП748А КП748Б КП748В	IRF610 IRF611 IRF612	200 150 200	1,5 1,5 2,4	3,3 3,3 2,6	±20	36	2,0÷4,0	КТ-28-2 -55÷125°С
КП749А КП749Б КП749В	IRF620 IRF621 IRF622	200 150 200	0,8 0,8 1,2	5,2 5,2 4,0	±20	50	2,0÷4,0	КТ-28-2 -55÷125°С
КП750А, А1 КП750Б, Б1 КП750В, В1	IRF640 IRF641 IRF642	200 150 200	0,18 0,18 0,22	18 18 16	±20	125	2,0÷4,0	КТ-28-2 КТ-90 -55÷125°С
КП751А, А1 КП751Б, Б1 КП751В, В1	IRF720 IRF721 IRF722	400 350 400	1,8 1,8 2,5	3,3 3,3 2,8	±20	50	2,0÷4,0	КТ-28-2 КТ-90 -55÷125°С
КП771А КП771Б КП771В	STP40N10	100 100 125	0,04 0,055 0,077	40 35 30	±20	150	2,0÷4,0	КТ-28-2 -55÷150°С
КП778А КП778Б КП778В	IRFP250	200 200 250	0,085 0,12 0,14	30 25 23	±20	190	2,0÷4,0	КТ-43 -55÷125°С
КП780А КП780Б КП780В	IRF820 IRF821 IRF822	500 450 500	3,0 3,0 4,0	2,5 2,5 2,2	±20	50	2,0÷4,0	КТ-28-2 -55÷125°С
КП780А9 КП780Б9 КП780В9 Разработка	IRFU420	500 450 500	3,0 3,0 4,0	2,5 2,5 2,2	±20	50	2,0÷4,0	КТ-89 -55÷125°С

• Мощные p-канальные полевые транзисторы

Обозначение	Прототип	Uси max В	Rси Ом	I c max А	Uзи max В	P max Вт	Uзи пор В	Тип корпуса Диапазон раб. темпер
КП7128Б	IRF5210	-100	0,08	-35	±20	200	-2,0÷(-4,0)	КТ-28-2 -55÷125°С
КП784А	IRF9Z34	-60	0,14	-18	±20	88	-2,0÷(-4,0)	КТ-28-2 -55÷125°С
КП785А	IRF9540	-100	0,20	-19	±20	150	-2,0÷(-4,0)	КТ-28-2 -55÷150°С
КП796А Разработка	IRF9634	-250	1,0	-4,1	±20	74	-2,0÷(-4,0)	КТ-28-2 -55÷150°С

• Мощные n-канальные полевые транзисторы, управляемые логическим уровнем напряжения

Обозначение	Прототип	Uси max В	Rси Ом	I c max А	Uзи max В	P max Вт	Uзи пор В	Тип корпуса Диапазон раб. темпер.
КП723Г	IRLZ44	60	0,028	50	±10	150	1,0÷2,0	КТ-28-2 -55÷150°С
КП727В	IRLZ34	60	0,05	30	±10	88	1,0÷2,0	КТ-28-2 -55÷150°С
КП737Г	IRL630	200	0,4	9,0	±10	74	1,0÷2,0	КТ-28-2 -55÷150°С
КП744Г	IRL520	100	0,27	9,2	±10	60	1,0÷2,0	КТ-28-2 -55÷150°С
КП745Г	IRL530	100	0,16	15	±10	88	1,0÷2,0	КТ-28-2 -55÷150°С
КП746Г КП746Г1	IRL540	100	0,077	28	±10	150	1,0÷2,0	КТ-28-2 КТ-90 -55÷150°С
КП750Г КП750Г1	IRL640 IRL640S	200	0,18	18	±10	125	1,0÷2,0	КТ-28-2 КТ-90 -55÷125°С
КП775А КП775Б КП775В	2SK2498	60 55 60	0,009 0,009 0,016	50	±20	150	1,0÷2,0	КТ-28-2 -60÷125°С

транзистор АНАЛОГИ Техническая информация datasheet pdf техническая документация технические характеристики описание фото рисунок маркировка габариты размер параметры применение аналог замена Предлагаем ЭЛЕКТРОННЫЕ КОМПОНЕНТЫ (радиодетали) СО СКЛАДА И ПОД ЗАКАЗ продажа в Минске Беларусь тел.8(017)200-56-46 www.fotorele.net e:mail minsk17@tut.by